

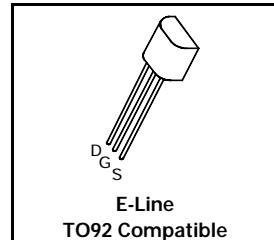
# N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ISSUE 2 - MARCH 94

**ZVN2106A**

## FEATURES

- \* 60 Volt  $V_{DS}$
- \*  $R_{DS(on)}=2\Omega$



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

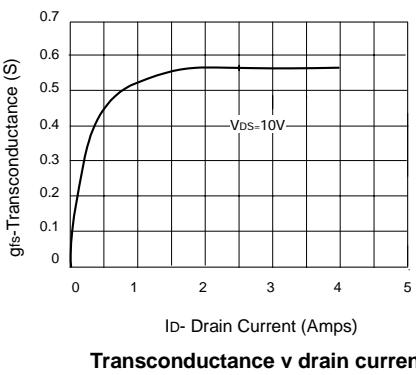
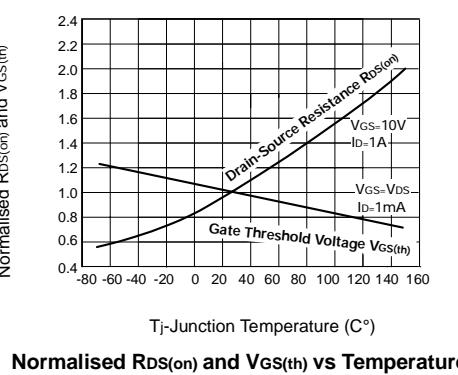
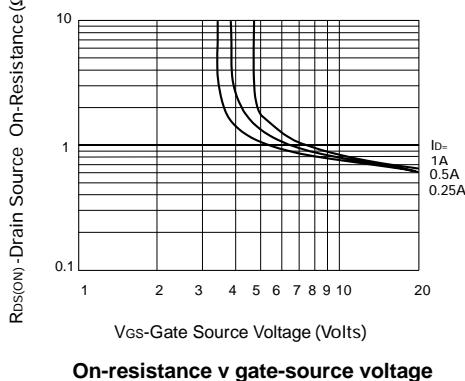
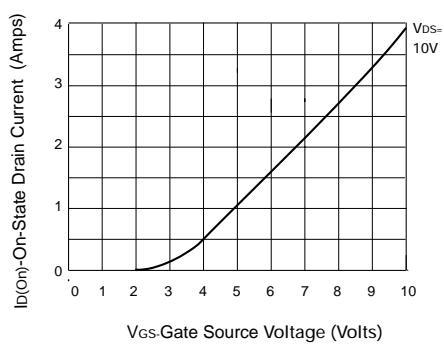
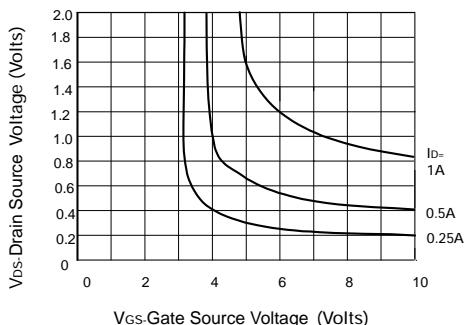
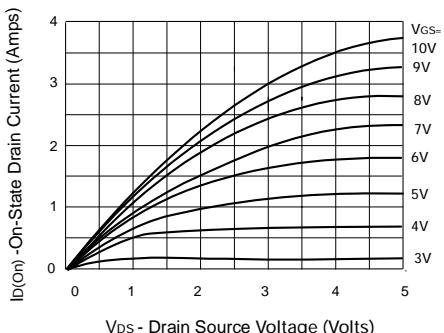
PARAMETER	SYMBOL	VALUE		UNIT
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	60		V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^\circ C$	$I_D$	450		mA
Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	8		A
Gate Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$		V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ C$	$P_{tot}$	700		mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150		°C

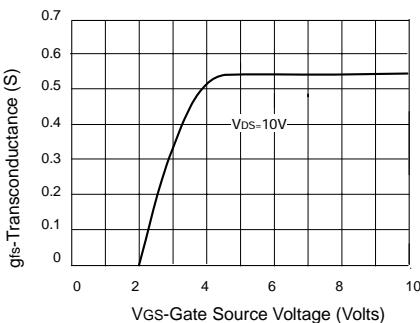
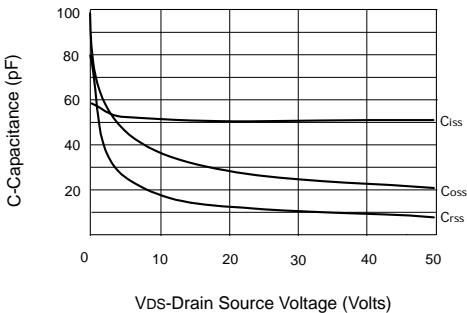
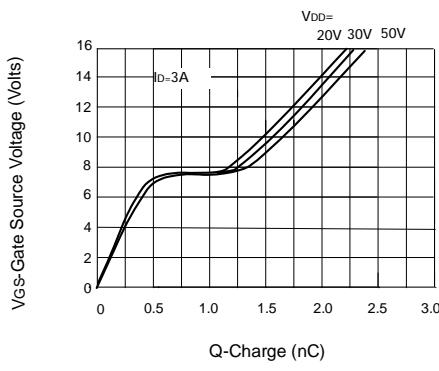
## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	60		V	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	2.4	V	$ID=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	$I_{GSS}$		20	nA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$		500 100	nA $\mu A$	$V_{DS}=60 V, V_{GS}=0$ $V_{DS}=48 V, V_{GS}=0V,$ $T=125^\circ C(2)$
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	2		A	$V_{DS}=18V, V_{GS}=10V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		2	$\Omega$	$V_{GS}=10V, I_D=1A$
Forward Transconductance (1)(2)	$g_{fs}$	300		$mS$	$V_{DS}=18V, I_D=1A$
Input Capacitance (2)	$C_{iss}$		75	pF	$V_{DS}=18 V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	$C_{oss}$		45	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	$C_{rss}$		20	pF	

# ZVN2106A

## TYPICAL CHARACTERISTICS



**TYPICAL CHARACTERISTICS****Transconductance v gate-source voltage****Capacitance v drain-source voltage****Gate charge v gate-source voltage**

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9